**Хамидуллина, Наталья Мугалимовна.**

**Влияние реальных параметров случайного поля на кинетику носителей заряда в неупорядоченных полупроводниках : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10. - Москва, 1984. - 82 с. : ил.**

**Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Хамидуллина, Наталья Мугалимовна**

**Введение к ШВЕ I . •**

**ГЛАВА I, Кинетика носителей заряда в легированных невыровненных полупроводниках.• \* • • II**

**§ I. Постановка задачи. Основные формулы • ••••••• II**

**§ 2. Подвижность в легированных полупроводниках с плотностью состояний £(E.yW. •**

**§ 3» Подвижность в легированных полупроводниках с гладким случайным полем • ••••••••••••**

**§ 4. Влияние межуровневой корреляции на величину радиуса экранирования в легированных невырожденных полупроводниках .♦•♦••••••••**

**Введение к ШВЕ П.**

**ГЛАВА П. Характеристики собственного случайного поля и кинетика носителей заряда в гидрогенизиро-ванном аморфном кремнии • ••••••••••••**

**§ I. Постановка задачи. Основные формулы • •••••••**

**§ 2. Характеристики радиальных функций распределения**

**В a-Si: Н • •••••••••••••**

**§ 3. Эффективные заряды связи кремния с водородом**

**§ 4. Оценка некоторых параметров бинарной корреляционной функции случайного ПОЛЯ В a-Si:H •••••••**

**§ 5» Оптический "хвост" В a-Si:H,**

**Выводы.••••••.**